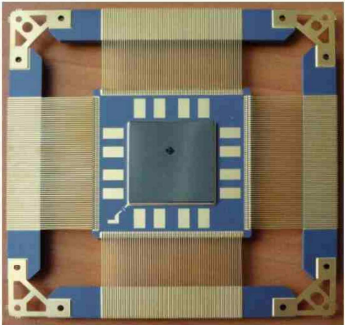




ПЛИС

Особенности:

- ✓ Категория качества – «ВП»;
- ✓ Функциональный аналог – EPF10K50 (ф. Altera) . Микросхемы могут быть использованы для замены аналогов: EPF10K30, EPF10K40, EPF10K50, EPF10K30E, EPF10K50E (ф. Altera), АЗР060 (ф. Actel), XC2S50 (Xilinx), АТ40КЕL040 (ф. Amtel);
- ✓ Среда конфигурирования ПЛИС – МАХ + Plus II или Quartus; ПО, разр. В ОАО «КТЦ Электроника», г. Воронеж
- ✓ Программируемый «Скрабинг» - режим;
- ✓ Программируемый режим верификации конфигурационной памяти без выхода из рабочего состояния;
- ✓ Программный тактовый генератор;
- ✓ Конфигурирование ПЛИС в пассивном последовательном режиме.
- ✓ Технические условия – АЕЯР.431260.888ТУ

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ
5576ХС6Т

Корпус 4245.256-3

Наименование параметра, единица измерения	Норма параметра
Напряжение питания ядра, В	1,8 ± 0,09
Напряжение питания периферии, В	3,3 ± 0,3
Диапазон температур окружающей среды, С°	от минус 60 до плюс 100
Типовая логическая емкость, вент	50 000
Объем встроенной памяти, Кбит	40
Количество логических элементов, шт.	2 880
Количество выводов, программируемых пользователем, шт.	150

Требования стойкости к внешним воздействиям

Вид специальных факторов	Характеристики специальных факторов	Значения характеристик специальных факторов	Номер пункта примечания
7.И	7.И ₁	4У _С	
	7.И ₆	5У _С	
	7.И ₇	5У _С	
	7.И ₈	0,1*1У _С	
7.С	7.С ₁	4У _С	
	7.С ₄	5*5У _С	
7.К	7.К ₁	10,5*2К (2К)	
	7.К ₄	0,55*2К	1
	7.К ₁₁	60 МэВ*см ² /мг	2

Примечания

1. При совместном воздействии факторов 7.К с характеристиками 7К1 и 7К4, значение характеристик – 0,53*2К
2. По катастрофическим отказам и тиристорному эффекту

- ✓ Микросхема должна быть стойкая к воздействию статического электричества с потенциалом не менее 1000 В;
- ✓ Допустимое время потери работоспособности микросхемы во время и непосредственно после воздействия факторов 7.И с характеристикой 7.И6 должно быть не более 2 мс.